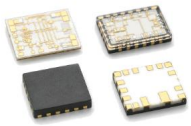
Catálogo de productos

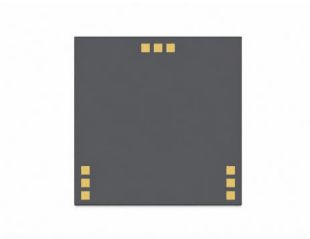
Dispositivos pasivos RF integrados

Los dispositivos pasivos integrados reúnen varios elementos en un sustrato o encapsulado. En RF pueden realizar adaptación, filtrado, conversión balun o acoplamiento.



Productos: 32

Revisión: 11 · Fecha de revisión: 2026-11-11



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 2 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidad: MHz

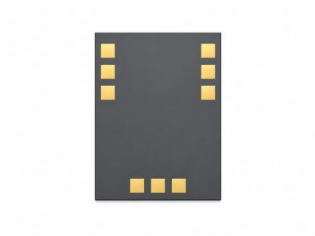
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 14 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 500; Máximo: 2700; Valor: 500–2700; Unidad: MHz

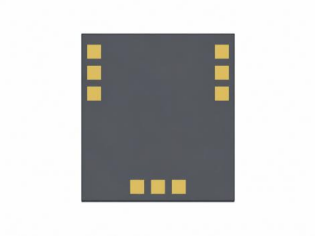
Aislamiento: Típico: 14; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidad: MHz

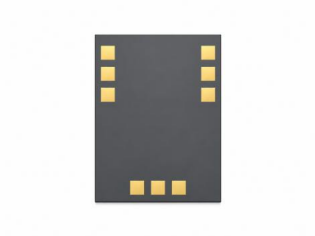
Aislamiento: Típico: 18; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.4 (típico); VSWR de salida: 1.4 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 1000; Máximo: 4000; Valor: 1000–4000; Unidad: MHz

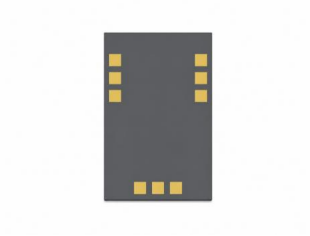
Aislamiento: Típico: 18; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de salida: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

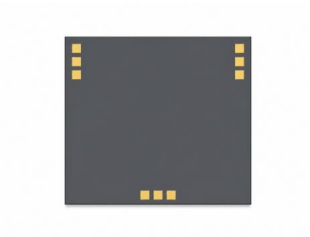
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

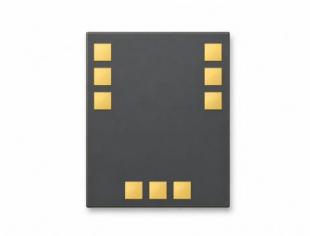
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

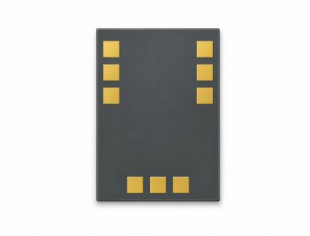
Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 7000; Valor: 5000–7000; Unidad: MHz

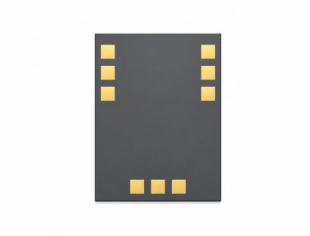
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

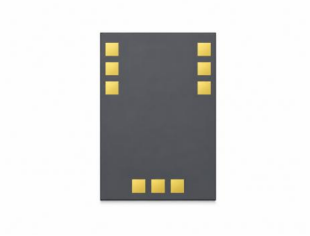
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

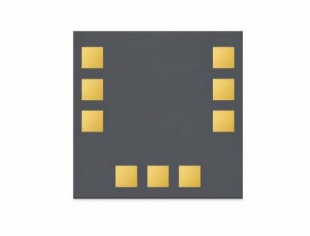
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

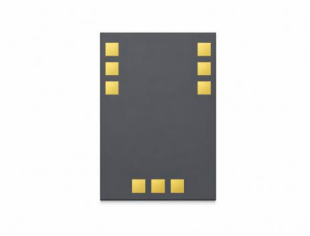
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 10000; Máximo: 20000; Valor: 10000–20000; Unidad: MHz

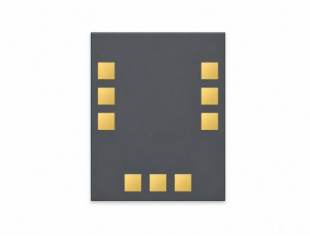
Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidad: MHz

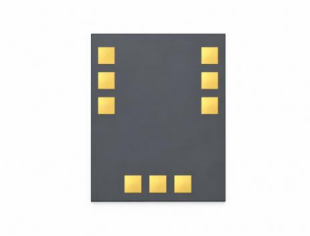
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 30000; Máximo: 40000; Valor: 30000–40000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.2 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.2

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 4 dB

Atenuación: 4 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 4; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 16 dB

Atenuación: 16 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 16; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.6 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.6; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.4 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.4

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 5 dB

Atenuación: 5 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 5; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 6 dB

Atenuación: 6 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 6; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 10 dB

Atenuación: 10 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

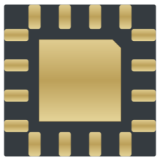
Atenuación: Valor: 10; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz Cruce RF encapsulado — ISO 30 dB (típico)

DC–40000 MHz; Pérdida de inserción -1.4 dB (típico); Aislamiento 30 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: -1.4; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.